

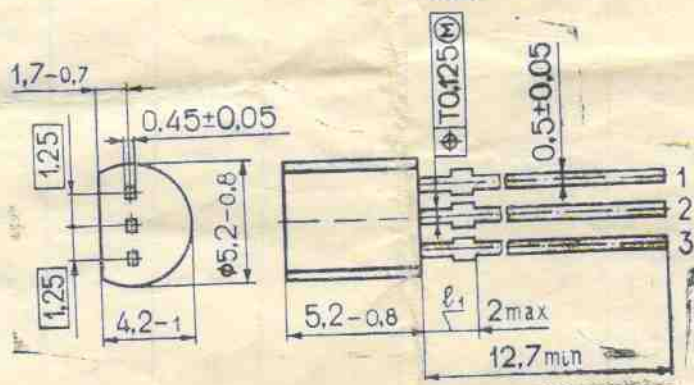


# Транзисторы КТ342АМ, КТ342БМ, КТ342ВМ, КТ342ГМ, КТ342ДМ

## ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные p-p-p универсальные транзисторы высокой частоты типов: КТ342АМ, КТ342БМ, КТ342ВМ, КТ342ГМ, КТ342ДМ, в пластмассовом корпусе, предназначенные для работы в приемо-усилительной аппаратуре, в цепях вычислительных машин и другой аппаратуре.

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 2.1.



1 — эмиттер, 2 — база, 3 — коллектор.

1.  $L_1$  — неконтролируемая и непригодная для монтажа длина вывода.
2. Позиционный допуск контролируется на расстоянии  $L_1$  max.

Масса — не более 0.3 г

Транзисторы трудногорючие, несамовоспламеняемые.

Тип транзистора обозначается кодом группа — соответствующей буквой, год и месяц изготовления указываются согласно таблицам 1 и 2.

Таблица 1

Год	Код	Год	Код
1986	U	1994	E
1987	V	1995	F
1988	W	1996	H
1989	X	1997	I
1990	A	1998	K
1991	B	1999	L
1992	C	2000	M
1993	D	2001	N

Таблица 2

Месяц	Код	Месяц	Код
Январь	1	Июль	7
Февраль	2	Август	8
Март	3	Сентябрь	9
Апрель	4	Октябрь	0
Май	5	Ноябрь	N
Июнь	6	Декабрь	D

Допускается маркировка транзисторов согласно табл. 3.

Таблица 3

Обозначение типа транзистора		Обозначение группы транзистора	
тип транзистора	цвет маркировочной метки на боковой поверхности корпуса	группа транзистора	цвет маркировочной метки на торце корпуса
КТ342	свиль	АМ	темно-красный
		БМ	желтый
		ВМ	темно-зеленый
		ГМ	голубой
		ДМ	свиль

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ  $t_{amb} = (25 \pm 10)^\circ C$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма		
		КТ342АМ КТ342ГМ	КТ342БМ КТ342ДМ	КТ342ВМ
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ( $I_C = 10 \text{ мА}$ , $I_B = 1 \text{ мА}$ ), $V$ , не более	$U_{CE sat}$	0,1	0,1	0,1
Напряжение насыщения база-эмиттер ( $I_C = 10 \text{ мА}$ , $I_B = 1 \text{ мА}$ ), $V$ , не более	$U_{BE sat}$	0,9	0,9	0,9
Граничное напряжение ( $I_C = 10 \text{ мА}$ ), $V$ , не менее	$U_{(L)CEO}$	25	20	10
Обратный ток коллектора ( $U_{CB} = 25 \text{ В}$ ), $\text{мкА}$ , не более	$I_{CBO}$	0,05		
( $U_{CB} = 20 \text{ В}$ ), $\text{мкА}$ , не более	$I_{CBO}$		0,05	
( $U_{CB} = 10 \text{ В}$ ), $\text{мкА}$ , не более	$I_{CBO}$			0,05
Обратный ток эмиттера ( $U_{EB} = 5 \text{ В}$ ), $\text{мкА}$ , не более	$I_{EBO}$	30	30	30
Обратный ток коллектор-эмиттер ( $R_{BE} = 10 \text{ кОм}$ ), ( $U_{CE} = 30 \text{ В}$ ), $\text{мкА}$ , не более	$I_{CER}$	30		
( $U_{CE} = 25 \text{ В}$ ), $\text{мкА}$ , не более	$I_{CER}$		30	
( $U_{CE} = 10 \text{ В}$ ), $\text{мкА}$ , не более	$I_{CER}$			30
Статический коэффициент передачи тока ( $U_{CB} = 5 \text{ В}$ , $I_E = 2 \text{ мА}$ ), в пределах	$h_{21E}$	100-250	200-500	400-1000
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ( $U_{CB} = 10 \text{ В}$ , $I_E = 5 \text{ мА}$ , $f = 100 \text{ МГц}$ ), не менее	$ h_{21e} $	2,5 1,5*	3,0 1,5*	3,0
Входное сопротивление в режиме малого сигнала ( $U_{CB} = 5 \text{ В}$ , $I_E = 1 \text{ мА}$ , $f = 1 \cdot 10^{-3} \text{ МГц}$ ), $\text{Ом}$ , не более	$h_{11B}$	200	200	200
Емкость коллекторного перехода ( $U_{CB} = 5 \text{ В}$ , $f = 10 \text{ МГц}$ ), $\text{пФ}$ , не более	$C_c$	8	8	8

\* Для группы КТ342ГМ, КТ342ДМ  
СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В ОДНОМ ТРАНЗИСТОРЕ:  
золото 0,0488 мг палладий 0,0012 мг

Выводы драгоценных металлов не содержат.  
СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ В ОДНОМ ТРАНЗИСТОРЕ: в транзисторе цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы КТ342АМ, КТ342БМ, КТ342ВМ, КТ342ГМ, КТ342ДМ соответ- ствуют техническим условиям 3.365.227 ТУ.

ОТК 372